

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4902726号
(P4902726)

(45) 発行日 平成24年3月21日(2012.3.21)

(24) 登録日 平成24年1月13日(2012.1.13)

(51) Int.Cl.

F I

H01L 51/50	(2006.01)	H05B 33/14	A
G09F 9/30	(2006.01)	G09F 9/30	338
H05B 33/02	(2006.01)	H05B 33/02	
H05B 33/26	(2006.01)	H05B 33/26	Z
H05B 33/28	(2006.01)	H05B 33/28	

請求項の数 5 (全 17 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2009-284940 (P2009-284940)
 (22) 出願日 平成21年12月16日(2009.12.16)
 (65) 公開番号 特開2010-199554 (P2010-199554A)
 (43) 公開日 平成22年9月9日(2010.9.9)
 審査請求日 平成21年12月16日(2009.12.16)
 (31) 優先権主張番号 10-2009-0015460
 (32) 優先日 平成21年2月24日(2009.2.24)
 (33) 優先権主張国 韓国(KR)

(73) 特許権者 501426046
 エルジー ディ스플레이 カンパニー リ
 ミテッド
 大韓民国 ソウル, ヨンドゥンポーク, ヨ
 イドンドン 20
 (74) 代理人 100110423
 弁理士 曾我 道治
 (74) 代理人 100084010
 弁理士 古川 秀利
 (74) 代理人 100094695
 弁理士 鈴木 憲七
 (74) 代理人 100111648
 弁理士 梶並 順
 (74) 代理人 100147566
 弁理士 上田 俊一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置及びその製造方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

金属基板上に配置されて光を生成する光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置され
 た第1及び第2パッド部と、

前記金属基板上に形成され、前記金属基板の導電特性を絶縁する絶縁層と、

前記光発生領域上に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタを覆って前記金属基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一
 部と前記第1パッド部の一部及び前記第2パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホ
 ールを含む保護層と、

前記保護層上に形成され、前記コンタクトホールを通じて露出された前記薄膜トランジ
 スタの一部と接触される第1及び第2導電パターンと、

前記光発生領域上に形成されて前記第2導電パターンと電氣的に接続されるカソード電
 極と、

前記カソード電極上に配置された有機発光層と、

前記有機発光層上に配置され、透明な導電金属で形成されたアノード電極と、

前記第1及び第2パッド部を露出する前記コンタクトホールの各々に、前記第2導電パ
 ターンと同一の物質で形成された電極パターンと、

を備え、

前記第1導電パターンはITOで形成され、前記第2導電パターンはモリブデンで形成
 され、

10

20

前記第 1 及び第 2 パッド部のそれぞれは、前記第 1 導電パターンと同一物質でなる第 1 上部電極及び前記第 2 導電パターンと同一物質でなる第 2 上部電極を含む
ことを特徴とする逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置。

【請求項 2】

前記カソード電極は、反射率の高い A l N d で形成されることを特徴とする請求項 1 に記載の逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置。

【請求項 3】

金属基板上に配置されて光を生成する光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部と、

前記金属基板上に形成され、前記金属基板の導電特性を絶縁する絶縁層と、

前記光発生領域上に形成された薄膜トランジスタと、

前記薄膜トランジスタを覆って前記金属基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層と、

前記保護層上に形成され、前記コンタクトホールを通じて露出された薄膜トランジスタの一部と接触される導電パターンと、

前記光発生領域上に形成されて前記導電パターンと電氣的に接続される第 1 カソード電極と、

前記第 1 カソード電極上に形成された第 2 カソード電極と、

前記第 2 カソード電極上に配置された有機発光層と、

前記有機発光層上に配置され、透明な導電金属で形成されたアノード電極と、

前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホール各々に、前記導電パターンと同一の物質で形成された電極パターンと、

を備え、

前記導電パターンは透明な金属材質である I T O で形成され、

前記第 1 カソード電極はモリブデンで形成され、前記第 2 カソード電極は A l N d で形成される

ことを特徴とする逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置。

【請求項 4】

光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部に区分された金属基板を準備する段階と、

前記金属基板の導電特性を絶縁するために前記金属基板上に絶縁層を形成する段階と、

前記絶縁層が形成された金属基板の光発生領域上に薄膜トランジスタを形成する段階と

、
前記薄膜トランジスタを覆って、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層を前記金属基板上に形成する段階と、

前記コンタクトホールを通じて露出された前記薄膜トランジスタの一部と接触するように、前記保護層が形成された前記金属基板上に第 1 及び第 2 金属層を順次積層し、前記第 1 及び第 2 金属層をパターニングして第 1 及び第 2 導電パターンを形成する段階と、

前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び第 2 パッド部の一部が露出されるように、前記第 1 及び第 2 導電パターンが形成された前記金属基板上に平坦化層を形成する段階と、

前記平坦化層が形成された前記金属基板上に、前記第 2 導電パターンと電氣的に接続されるカソード電極を形成する段階と、

前記カソード電極が形成された前記金属基板上に、バンク層を形成して前記カソード電極の一部と前記第 1 及び第 2 パッド部の一部とが露出されるように、前記バンク層をパターニングしてバンクパターンを形成する段階と、

前記カソード電極上に有機発光層を形成する段階と、

前記有機発光層上に透明な導電金属でアノード電極を形成する段階と、

を含み、

前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホール of 各々には、前記第 2 導電パターンと同一の物質で電極パターンが形成され、

前記第 1 導電パターンはモリブデンで形成され、前記第 2 導電パターンは I T O で形成され、

前記第 1 及び第 2 パッド部のそれぞれは、前記第 1 導電パターンの第 1 上部電極及び前記第 2 導電パターンの第 2 上部電極を含む

ことを特徴とする逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造方法。

【請求項 5】

光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部に区分された金属基板を準備する段階と、

前記金属基板の導電特性を絶縁するために前記金属基板上に絶縁層を形成する段階と、
前記絶縁層が形成された金属基板の光発生領域上に薄膜トランジスタを形成する段階と

、
前記薄膜トランジスタを覆って、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層を前記金属基板上に形成する段階と、

前記コンタクトホールを通じて露出された前記薄膜トランジスタの一部と接触するように、前記保護層が形成された前記金属基板上に導電金属層を積層し、前記導電金属層をパターンニングして導電パターンを形成する段階と、

前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び第 2 パッド部の一部とが露出されるように、前記導電パターンが形成された前記金属基板上に平坦化層を形成する段階と、

前記導電パターンと電氣的に接続されるように、前記平坦化層が形成された前記金属基板上に第 1 及び第 2 金属層を順次積層し、前記第 1 及び第 2 金属層をパターンニングして第 1 及び第 2 カソード電極を形成する段階と、

前記第 1 及び第 2 カソード電極が形成された前記金属基板上に、バンク層を形成して前記第 2 カソード電極の一部と前記第 1 及び第 2 パッド部の一部とが露出されるように、前記バンク層をパターンニングしてバンクパターンを形成する段階と、

前記第 2 カソード電極上に有機発光層を形成する段階と、

前記有機発光層上に透明な導電金属でアノード電極を形成する段階と、

を含み、

前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホール of 各々には、前記導電パターンと同一の物質で電極パターンが形成され、

前記第 1 カソード電極はモリブデンで形成され、前記第 2 カソード電極は A l N d で形成され、

前記導電パターンは、透明な金属材質である I T O で形成される

ことを特徴とする逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機発光ダイオード表示装置に関し、特に金属基板上に薄膜トランジスタ (T F T) を形成する製造工程を減らすことができる逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置 (t o p e m i s s i o n i n v e r t e d O L E D d e v i c e) 及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

有機発光ダイオード表示装置は、自己発光型であり、液晶表示装置のようなバックライ

10

20

30

40

50

トを必要としないので、軽量薄型が可能であるだけでなく、単純な工程を経て製造することができる。また、有機発光ダイオード表示装置は、低電圧駆動、高い発光効率、広い視野角を有することにより、次世代ディスプレイとして急成長している。

【0003】

有機発光ダイオード表示装置は、基板上に配置された薄膜トランジスタ、薄膜トランジスタと電氣的に接続されて光を発生する有機発光ダイオード素子及び有機発光ダイオード素子を覆う封止基板を含む。ここで、有機発光ダイオード表示装置は、光が放出される方向によって、ボトムエミッション (bottom emission) 型及びトップエミッション (top emission) 型に区分することができる。

【0004】

トップエミッション型の有機発光ダイオード表示装置は、封止基板を通じて光を放出するので、ボトムエミッション型の有機発光ダイオード表示装置に比べて大きい開口率を確保することができる。また、トップエミッション型の有機発光ダイオード表示装置は、開口率が駆動素子による影響を受けないので、多様に設計することができる。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、トップエミッション型の有機発光ダイオード表示装置では、薄膜トランジスタ (TFT) を製作する工程において、最大 11 枚のマスクが使用される。そのため、薄膜トランジスタ (TFT) を製作する工程が極めて複雑になり、製造工程の効率が減少するとともに、製造費用が増加するという問題がある。

【0006】

また、トップエミッション型の有機発光ダイオード表示装置は、腐蝕性を有する導電物質を利用して各画素別にパターニングされたカソード電極と、カソード電極上に形成された有機発光層及びアノード電極とを有している。そのため、カソード電極は腐蝕されやすい。このようなカソード電極の腐蝕によって、トップエミッション型の有機発光ダイオード表示装置の信頼性が低下するという問題点もある。

【0007】

本発明の目的は、信頼性の高い逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置及びその製造方法を提供することである。

【0008】

本発明の別の目的は、製造工程の簡素化された逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置及びその製造方法を提供することである。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、金属基板上に配置されて光を生成する光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部と、前記金属基板上に形成され、前記金属基板の導電特性を絶縁する絶縁層と、前記光発生領域上に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆って前記金属基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層と、前記保護層上に形成され、前記コンタクトホールを通じて露出された前記薄膜トランジスタの一部と接触される第 1 及び第 2 導電パターンと、前記光発生領域上に形成されて前記第 2 導電パターンと電氣的に接続されるカソード電極と、前記カソード電極上に配置された有機発光層と、前記有機発光層上に配置され、透明な導電金属で形成されたアノード電極と、前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホールの各々に、前記第 2 導電パターンと同一の物質で形成された電極パターンとを備え、前記第 1 導電パターンは ITO で形成され、前記第 2 導電パターンはモリブデンで形成され、前記第 1 及び第 2 パッド部のそれぞれは、前記第 1 導電パターンと同一物質でなる第 1 上部電極及び前記第 2 導電パターンと同一物質でなる第 2 上部電極を含むことを特徴とする。

また、本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、金属基板上に配置されて光を生成する光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部と、前記金属基板上に形成され、前記金属基板の導電特性を絶縁する絶縁層と、前記光発生領域上に形成された薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタを覆って前記金属基板上に配置され、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層と、前記保護層上に形成され、前記コンタクトホールを通じて露出された薄膜トランジスタの一部と接触される導電パターンと、前記光発生領域上に形成されて前記導電パターンと電氣的に接続される第 1 カソード電極と、前記第 1 カソード電極上に形成された第 2 カソード電極と、前記第 2 カソード電極上に配置された有機発光層と、前記有機発光層上に配置され、透明な導電金属で形成されたアノード電極と、前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホール各々に、前記導電パターンと同一の物質で形成された電極パターンとを備え、前記導電パターンは透明な金属材質である I T O で形成され、前記第 1 カソード電極はモリブデンで形成され、前記第 2 カソード電極は A l N d で形成されることを特徴とする。

10

また、本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造方法は、光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部に区分された金属基板を準備する段階と、前記金属基板の導電特性を絶縁するために前記金属基板上に絶縁層を形成する段階と、前記絶縁層が形成された金属基板の光発生領域上に薄膜トランジスタを形成する段階と、前記薄膜トランジスタを覆って、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層を前記金属基板上に形成する段階と、前記コンタクトホールを通じて露出された前記薄膜トランジスタの一部と接触するように、前記保護層が形成された前記金属基板上に第 1 及び第 2 金属層を順次積層し、前記第 1 及び第 2 金属層をパターニングして第 1 及び第 2 導電パターンを形成する段階と、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び第 2 パッド部の一部が露出されるように、前記第 1 及び第 2 導電パターンが形成された前記金属基板上に平坦化層を形成する段階と、前記平坦化層が形成された前記金属基板上に、前記第 2 導電パターンと電氣的に接続されるカソード電極を形成する段階と、前記カソード電極が形成された前記金属基板上に、バンク層を形成して前記カソード電極の一部と前記第 1 及び第 2 パッド部の一部とが露出されるように、前記バンク層をパターニングしてバンクパターンを形成する段階と、前記カソード電極上に有機発光層を形成する段階と、前記有機発光層上に透明な導電金属でアノード電極を形成する段階とを含み、前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホールの各々には、前記第 2 導電パターンと同一の物質で電極パターンが形成され、前記第 1 導電パターンはモリブデンで形成され、前記第 2 導電パターンは I T O で形成され、前記第 1 及び第 2 パッド部のそれぞれは、前記第 1 導電パターンの第 1 上部電極及び前記第 2 導電パターンの第 2 上部電極を含むことを特徴とする。

20

30

さらに、本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造方法は、光発生領域及び前記光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パッド部に区分された金属基板を準備する段階と、前記金属基板の導電特性を絶縁するために前記金属基板上に絶縁層を形成する段階と、前記絶縁層が形成された金属基板の光発生領域上に薄膜トランジスタを形成する段階と、前記薄膜トランジスタを覆って、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び前記第 2 パッド部の一部とを各々露出するコンタクトホールを含む保護層を前記金属基板上に形成する段階と、前記コンタクトホールを通じて露出された前記薄膜トランジスタの一部と接触するように、前記保護層が形成された前記金属基板上に導電金属層を積層し、前記導電金属層をパターニングして導電パターンを形成する段階と、前記薄膜トランジスタの一部と前記第 1 パッド部の一部及び第 2 パッド部の一部とが露出されるように、前記導電パターンが形成された前記金属基板上に平坦化層を形成する段階と、前記導電パターンと電氣的に接続されるように、前記平坦化層が形成された前記金属基板上に第 1 及び第 2 金属層を順次積層し、前記第 1 及び第 2 金属層を

40

50

パターンニングして第 1 及び第 2 カソード電極を形成する段階と、前記第 1 及び第 2 カソード電極が形成された前記金属基板上に、バンク層を形成して前記第 2 カソード電極の一部と前記第 1 及び第 2 パッド部の一部とが露出されるように、前記バンク層をパターンニングしてバンクパターンを形成する段階と、前記第 2 カソード電極上に有機発光層を形成する段階と、前記有機発光層上に透明な導電金属でアノード電極を形成する段階とを含み、前記第 1 及び第 2 パッド部を露出する前記コンタクトホールは、前記導電パターンと同一の物質で電極パターンが形成され、前記第 1 カソード電極はモリブデンで形成され、前記第 2 カソード電極は A l N d で形成され、前記導電パターンは、透明な金属材質である I T O で形成されることを特徴とする。

【発明の効果】

10

【 0 0 1 3 】

本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、既存の有機発光ダイオード表示装置で薄膜トランジスタ (T F T) を形成する製造工程の一部を活用して、金属基板上にトップエミッション構造の薄膜トランジスタ (T F T) を形成することにより、従来の最大 1 1 枚のマスク工程を 8 マスク工程に減らすことができ、製造工程を単純化させて製造費用を節減することができる。

【図面の簡単な説明】

【 0 0 1 4 】

【図 1】本発明の実施の形態 1 に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置を概略的に示す断面図である。

20

【図 2 A】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 B】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 C】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 D】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 E】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

30

【図 2 F】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 G】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 H】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 I】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 J】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

40

【図 2 K】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 L】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 M】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 N】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 O】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

50

【図 2 P】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 2 Q】図 1 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 3】本発明の実施の形態 2 に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置を概略的に示す断面図である。

【図 4 A】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 B】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 C】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 D】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 E】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 F】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 G】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 H】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 I】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 J】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 K】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 L】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 M】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 N】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 O】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【図 4 P】図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0015】

以下、添付した図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。

【0016】

実施の形態 1 .

図 1 は、本発明の実施の形態 1 に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置を概略的に示す断面図である。本発明の実施の形態 1 に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置では、第 1 電極がカソード電極であり、第 2 電極がアノード電極である逆構造 (i n v e r t e d) について例を挙げて説明する。

【0017】

図 1 に示されたように、本発明の実施の形態 1 に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、光発生領域と光発生領域の周辺に配置された第 1 及び第 2 パ

10

20

30

40

50

ッド部とを含む基板 100 を具備している。このとき、基板 100 は、金属物質から形成される。第 1 パッド部は、ゲートパッド部を含み、第 2 パッド部は、データパッド部を含む。

【0018】

光発生領域には、少なくとも一つの薄膜トランジスタ (TR) が形成されている。薄膜トランジスタ (TR) は、ゲート電極 102 と、ゲート電極 102 を覆うゲート絶縁膜 110 と、ゲート電極 102 と対応してゲート絶縁膜 110 上に配置された半導体パターン 104 と、半導体パターン 104 上の一定領域に配置されたソース電極 106 及びドレーン電極 108 とを含む。ここで、半導体パターン 104 は、不純物がドーピングされた非晶質シリコンパターンからなる活性層 104a と、不純物がドーピングされた非晶質シリコンパターンからなるオーミックコンタクト層 104b とを含む。オーミックコンタクト層 104b は、活性層 104a とソース電極 106 との間、及び活性層 104a とドレーン電極 108 との間に各々配置される。

10

【0019】

基板 100 は、薄膜トランジスタ (TR) を覆う保護層 120 を含む。保護層 120 は、無機絶縁物質から形成される。例えば、保護層 120 は、シリコン酸化物またはシリコン窒化物から形成される。薄膜トランジスタ (TR) と対応した保護層 120 上には、第 1 導電パターン 122 と第 2 導電パターン 124 とが形成される。薄膜トランジスタ (TR) 上に形成された保護層 120 には、ドレーン電極 108 の一部を露出する第 2 コンタクトホール (H2) が形成される。これにより、第 1 導電パターン 122 は、第 2 コンタクトホール (H2) を経由してドレーン電極 108 と電氣的に接続される。

20

【0020】

ゲートパッド部は、ゲート電極 102 と同一金属で形成されたゲートパッド下部電極 102a と、ゲートパッド下部電極 102a 上に形成されたゲート絶縁膜 110 と、ゲート絶縁膜 110 上に形成された保護層 120 と、ゲートパッド下部電極 102a と対応して保護層 120 上に形成された第 1 及び第 2 ゲートパッド上部電極 122a、124a とを含む。ゲートパッド部の保護層 120 及びゲート絶縁膜 110 には、ゲートパッド下部電極 102a の一部を露出する第 1 コンタクトホール (H1) が形成される。第 1 ゲートパッド上部電極 122a は、第 1 コンタクトホール (H1) を経由してゲートパッド下部電極 102a と電氣的に接続される。

30

【0021】

データパッド部は、基板 100 上に形成されたゲート絶縁膜 110 と、ゲート絶縁膜 110 上に、薄膜トランジスタ (TR) のソース及びドレーン電極 106、108 と同一金属で形成されたデータパッド下部電極 106a と、データパッド下部電極 106a 上に形成された保護層 120 と、データパッド下部電極 106a と対応して保護層 120 上に形成された第 1 及び第 2 データパッド上部電極 122b、124b とを含む。データパッド部の保護層 120 には、データパッド下部電極 106a の一部を露出する第 3 コンタクトホール (H3) が形成され、データパッド上部電極 122b は、第 3 コンタクトホール (H3) を経由してデータパッド下部電極 106a と電氣的に接続される。第 1 ゲートパッド上部電極 122a、第 1 データパッド上部電極 122b 及び第 1 導電パターン 122 は、互いに同一の材質から形成される。第 2 ゲートパッド上部電極 124a、第 2 データパッド上部電極 124b 及び第 2 導電パターン 124 は、互いに同一の材質から形成される。

40

【0022】

薄膜トランジスタ (TR) とゲート及びデータパッド部が形成された基板 100 の全面に、平坦化層 130 が形成される。平坦化層 130 は、ポリイミド、ポリアクリルのような有機物質から形成される。平坦化層 130 は、平坦な上面を有し、薄膜トランジスタ (TR) とゲート及びデータパッド部とによって形成された段差を解消する。

【0023】

平坦化層 130 が形成されて光発生領域と対応した基板 100 上に、第 2 導電パターン

50

１２４と電氣的に接続されたカソード電極１４０が形成され、カソード電極１４０が形成された基板１００上に、カソード電極１４０の一部を露出させるバンクパターン１５０が形成される。バンクパターン１５０は、ポリイミド等の感光性絶縁物質を蒸着する工程、フォトリソグラフィーによって絶縁物質をパターニングする工程を経て、カソード電極１４０を取り囲むように形成される。通常、逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置が多数の発光ダイオードを含むにつれて、バンクパターン１５０は、カソード電極等１４０間に形成される。

【００２４】

図２Ａ～図２Ｑは、図１に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

10

【００２５】

図２Ａに示されたように、金属基板１００上に第１金属層１０１が形成される。金属基板１００の導電特性に応じて、第１金属層１０１の形成前に絶縁膜が金属基板１００上に塗布されてもよい。第１導電層１０１は、第１マスクを利用したフォトリソグラフィー工程を通じてパターニングされ、図２Ｂに示されたゲート電極１０２とゲートパッド下部電極１０２ａとが形成される。ゲート電極１０２は、光発生領域上に形成され、ゲートパッド下部電極１０２ａは、光発生領域周辺のゲートパッド部上に形成される。

【００２６】

ゲート電極１０２とゲートパッド下部電極１０２ａとが形成された金属基板１００の全面に、図２Ｃに示されたように、ゲート絶縁膜１１０が形成される。ゲート絶縁膜１１０が形成された金属基板１００の全面に、非晶質シリコン薄膜１０３と、不純物がドーピングされた非晶質シリコン薄膜１０５とが順次積層される。順次積層された非晶質シリコン薄膜１０３と、不純物がドーピングされた非晶質シリコン薄膜１０５とのそれぞれは、第２マスクを利用したフォトリソグラフィー工程を通じてパターニングされ、図２Ｄに示されたように、ゲート電極１０２と対応した活性層パターン１０４ａ及びオーミックコンタクト層１０４ｂにパターニングされる。活性層パターン１０４ａ及びオーミックコンタクト層１０４ｂは、半導体パターン１０４を構成する。

20

【００２７】

半導体パターン１０４が形成された金属基板１００の全面に、図２Ｅに示されたように、第２金属層１０７が形成される。第２金属層１０７は、第３マスクを利用したフォトリソグラフィー工程を通じて、図２Ｆに示されたように、一定間隔離隔されたソース電極１０６及びドレイン電極１０８と、光発生領域の周辺領域のうち異なる一つの光発生領域に対応するデータパッド領域に位置するデータパッド下部電極１０６ａとにパターニングされる。これと同時に、ソース及びドレイン電極１０６、１０８の間に活性層１０４ａが露出されるように、オーミックコンタクト層１０４ｂが除去される。

30

【００２８】

ソース電極１０６及びドレイン電極１０８とデータパッド下部電極１０６ａとが形成された金属基板１００上に、図２Ｇに示されたように、保護パターン１１９が形成される。保護パターン１１９は、第４マスクを利用した工程を通じて、図２Ｈに示されたように、ゲートパッド下部電極１０２ａの一部を露出する第１コンタクトホール（Ｈ１）、ドレイン電極１０８の一部を露出する第２コンタクトホール（Ｈ２）及びデータパッド下部電極１０６ａの一部を露出する第３コンタクトホール（Ｈ３）を含む保護層１２０にパターニングされる。第１コンタクトホール（Ｈ１）は、ゲートパッド部上に形成され、第２コンタクトホール（Ｈ２）は、光発生領域上に形成され、第３コンタクトホール（Ｈ３）は、データパッド部上に形成される。

40

【００２９】

続いて、保護層１２０が形成された金属基板１００上に、図２Ｉに示されたように、第１導電層１２３と第２導電層１２５とが順次積層される。第１導電層１２３は、ＩＴＯを含んで形成され、第２導電層１２５は、モリブデンを含んで形成される。モリブデンから形成される第２導電層１２５は、ＩＴＯから形成される第１導電層１２３と後述するカソ

50

ード電極（図１の１４０）との間のガルバニック（Galvanic）現象を防ぐために挿入される。第１及び第２導電層１２３、１２５は、第５マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じてパターンニングされ、図２Ｊに示されたように、第１及び第２導電パターン１２２、１２４、第１及び第２ゲートパッド上部電極１２２ａ、１２４ａ並びに第１及び第２データパッド上部電極１２２ｂ、１２４ｂに区分される。

【００３０】

具体的に、第１導電層１２３は、第１導電パターン１２２、第１ゲートパッド上部電極１２２ａ及び第１データパッド上部電極１２２ｂにパターンニングされる。第２導電層１２５は、第２導電パターン１２４、第２ゲートパッド上部電極１２４ａ及び第２データパッド上部電極１２４ｂにパターンニングされる。第１及び第２導電パターン等１２２、１２４の積層パターンは、保護膜１２０上に配置されて、ドレーン電極１０８と対応し、第２コンタクトホール（Ｈ２）を経由してドレーン電極１０８と電氣的に接続される。第１及び第２ゲートパッド上部電極１２２ａ、１２４ａの積層パターンは、保護膜１２０上に配置されて、ゲートパッド下部電極１０２ａと対応し、第１コンタクトホール（Ｈ１）を経由してゲートパッド下部電極１０２ａと電氣的に接続される。第１及び第２データパッド上部電極等１２２ｂ、１２４ｂの積層パターンは、保護膜１２０上に配置されて、データパッド下部電極１０６ａと対応し、第３コンタクトホール（Ｈ３）を経由してデータパッド下部電極１０６ａと電氣的に接続される。

【００３１】

第１及び第２ゲートパッド上部電極１２２ａ、１２４ａ、第１及び第２データパッド上部電極等１２２ｂ、１２４ｂ並びに第１及び第２導電パターン等１２２、１２４が形成された金属基板１００上に、図２Ｋに示されたように、平坦化パターン１２９が形成される。平坦化パターン１２９は、第６マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じてパターン化され、図２Ｌに示されたように、第１～第３コンタクトホール（Ｈ１～Ｈ３）を有するパターン化された平坦化層１３０となる。

【００３２】

平坦化層１３０が形成された金属基板１００の全面に、図２Ｍに示されたように、第３金属層１３９が形成される。第３金属層１３９は、反射率がよいＡｌＮｄから形成される。ＡｌＮｄで形成された第３金属層１３９は、第７マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて、図２Ｎに示されたように、第２導電パターン１２４と電氣的に接続されるカソード電極１４０にパターンニングされる。

【００３３】

カソード電極１４０が形成された金属基板１００の全面に、図２Ｏに示されたように、バンク層１４９が形成される。バンク層１４９は、第８マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて、図２Ｐに示されたように、カソード電極１４０の一部と、第１及び第３コンタクトホール（Ｈ１、Ｈ３）とを露出させるバンクパターン１５０にパターンニングされる。即ち、第２ゲートパッド上部電極１２４ａ及び第２データパッド上部電極１２４ｂが、第１及び第３コンタクトホール（Ｈ１、Ｈ３）によって露出される。

【００３４】

続いて、バンク層１５０が形成された金属基板１００は、ドライエッチングされる。ドライエッチングを通じて、図２Ｑに示されたように、第１コンタクトホール（Ｈ１）上で第２ゲートパッド上部電極１２４ａが除去され、第３コンタクトホール（Ｈ３）上で第２データパッド上部電極１２４ｂが除去される。ドライエッチングを通じて第２ゲートパッド上部電極１２４ａが除去され、第１コンタクトホール（Ｈ１）上には、ＩＴＯで形成された第１ゲートパッド上部電極１２２ａだけが露出される。また、ドライエッチングを通じて第２データパッド上部電極１２４ｂが除去され、第３コンタクトホール（Ｈ３）上には、ＩＴＯで形成された第１データパッド上部電極１２２ｂだけが露出される。

【００３５】

続いて、ドライエッチング工程を経た金属基板１００上に、有機発光層（図示しない）と有機発光層上にアノード電極（図示しない）とが形成される。アノード電極は、透明な

10

20

30

40

50

導電性金属から形成される。

【0036】

このように、既存の6マスクを利用して基板上に薄膜トランジスタを形成する有機発光ダイオード表示装置の製造工程の一部を活用することで、計8枚のマスクのみを利用して逆構造トップエミッション型構造を有する有機発光ダイオード表示装置を製造することができ、既存の逆構造トップエミッション型構造を有する有機発光ダイオード表示装置に比べてマスク数を減らすことができる。すなわち、実施の形態1に係る逆構造トップエミッション発光ダイオード表示装置の製造方法では、従来の最大11マスク工程を8マスク工程に減らすことができる。これによって、製造工程が単純になり、製造費用を節減することができる。また、本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、既存の有機発光ダイオード表示装置の製造工程中のモジュール工程との互換を容易に行うことができる。

10

【0037】

図3は、本発明の実施の形態2に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置を概略的に示す断面図である。実施の形態2に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、図1に示したカソード電極140、第2導電パターン124、第2ゲートパッド上部電極124a及び第2データパッド上部電極124bに代えて、第1及び第2カソード電極242、244の積層パターンを有することを除いては、実施の形態1に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置と同一の構成を有する。従って、本発明の実施の形態2において、実施の形態1と重複する部分は、説明を省略することとし、同一の構成要素に対しては同一の名称及び符号を付することとする。

20

【0038】

図3に示されたように、本発明の実施の形態2に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、光発生領域と光発生領域の周辺に配置されたゲート及びデータパッド部とを含む金属基板100を具備している。

【0039】

光発生領域には、少なくとも一つの薄膜トランジスタ(TR)が形成されている。薄膜トランジスタ(TR)は、ゲート電極102と、ゲート電極102上に形成されたゲート絶縁膜110と、ゲート電極102に対応するようにゲート絶縁膜110上に形成された半導体パターン104と、半導体パターン104上に互いに一定間隔離隔して配置されたソース及びドレーン電極106、108と、ソース及びドレーン電極106、108が形成された金属基板100上に形成された保護層120とを含む。

30

【0040】

逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、光発生領域上の薄膜トランジスタ(TR)を覆う保護層120上に配置され、薄膜トランジスタ(TR)のドレーン電極108と電氣的に接続された導電パターン225を含む。

【0041】

ゲートパッド部は、ゲート電極102と同一金属で形成されたゲートパッド下部電極102aと、ゲートパッド下部電極102a上に順次形成されたゲート絶縁層110、保護層120及び保護層120上に形成されてゲートパッド下部電極102aと電氣的に接続されたゲートパッド上部電極225aとを含む。

40

【0042】

データパッド部は、ソース電極106と同一金属で形成されたデータパッド下部電極106aと、データパッド下部電極106a上に形成された保護層120と、保護層120上に形成されてデータパッド下部電極106aと電氣的に接続されたデータパッド上部電極225bとを含む。

【0043】

導電パターン225、ゲートパッド上部電極225a及びデータパッド上部電極225bが形成された金属基板100上に、平坦化層230が形成される。光発生領域に対応し

50

た平坦化層 230 上に、導電パターン 225 と電氣的に接続された第 1 及び第 2 カソード電極 242、244 が形成される。第 1 及び第 2 カソード電極 242、244 が形成された金属基板 100 上には、第 2 カソード電極 244 の一部が露出されるようにパターンニングされたバンク層 250 が形成される。

【0044】

図 4A ~ 図 4P は、図 3 に示した逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造工程を順に示す断面図である。

【0045】

図 4A ~ 図 4H の製造工程は、図 2A ~ 図 2H と同一なので、これに対する説明は省略することにする。ここで、図 4A ~ 図 4H にかけて、計 4 枚のマスクを利用した製造工程は、既存の有機発光ダイオード表示装置で薄膜トランジスタ (TR) を形成する工程と同一の工程である。

【0046】

続いて、保護層 120 が形成された金属基板 100 上に、図 4I に示されたように、ITO で形成された導電層 224 が積層される。導電層 224 は、第 5 マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて、図 4J に示されたように、導電パターン 225、ゲートパッド上部電極 225a 及びデータパッド上部電極 225b にパターンニングされる。

【0047】

導電パターン 225、ゲートパッド上部電極 225a 及びデータパッド上部電極 225b が形成された金属基板 100 上に、図 4K に示されたように、平坦化パターン 229 が形成される。平坦化パターン 229 は、第 6 マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて、図 4L に示されたように、第 1 ~ 第 3 コンタクトホール (H1 ~ H3) を有する平坦化層 230 にパターンニングされる。

【0048】

平坦化層 230 が形成された金属基板 100 の全面に、図 4M に示されたように、第 3 及び第 4 金属層 241、243 が形成される。第 3 金属層 241 は、モリブデンから形成され、第 4 金属層 243 は、反射率がよい AlNd から形成される。第 3 及び第 4 金属層等 241、243 は、第 7 マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて、図 4N に示されたように、光発生領域上に位置する第 1 及び第 2 カソード電極 242、244 にパターンニングされる。第 1 カソード電極 242 は、第 2 コンタクトホール (H2) を経由して導電パターン 225 と電氣的に接続される。ここで、平坦化層 230 上に AlNd で形成された第 2 カソード電極 244 を形成する際、接着力の問題が発生するので、モリブデンで形成された第 1 カソード電極 242 を平坦化層 230 と第 2 カソード電極 244 との間に形成する。このように、本発明の実施の形態 2 に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、モリブデン及び AlNd からなる二重金属層 242、244 でカソード電極を形成する。

【0049】

第 1 及び第 2 カソード電極 242、244 が形成された金属基板 100 の全面に、図 4O に示されたように、バンク層 249 が形成される。バンク層 249 は、第 8 マスクを利用したフォトリソグラフィ工程を通じて、図 4P に示されたように、第 2 カソード電極 244 の一部と、第 1 及び第 3 コンタクトホール (H1、H3) とを露出させるバンクパターン 250 にパターンニングされる。この場合、ゲートパッド上部電極 255a 及びデータパッド上部電極 225b は、第 1 及び第 3 コンタクトホール (H1、H3) を通じて各々露出される。

【0050】

続いて、上のような工程を経た金属基板 100 上に、有機発光層 (図示しない) と有機発光層上にアノード電極 (図示しない) とが形成される。アノード電極は、透明な導電性金属から形成される。

【0051】

ゲートパッド部の第 1 コンタクトホール上に ITO で形成されたゲートパッド上部電極

10

20

30

40

50

225aが露出され、データパッド部の第3コンタクトホール(H3)上にITOで形成されたデータパッド上部電極225bが露出されるので、ゲートパッド部及びデータパッド部は、トップエミッション構造で形成される。

【0052】

このように、既存の6マスクを利用して基板上に薄膜トランジスタを形成する有機発光ダイオード表示装置の製造工程の一部を活用することで、計8枚のマスクのみを利用して逆構造トップエミッション型構造を有する有機発光ダイオード表示装置を製造することができ、既存の逆構造トップエミッション型構造を有する有機発光ダイオード表示装置に比べてマスク数を減らすことができる。すなわち、実施の形態2に係る逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置の製造方法では、従来の最大11マスク工程を8マ
10
スク工程に減らすことができる。これによって、製造工程が単純になり、製造費用を節減することができる。また、本発明による逆構造トップエミッション型有機発光ダイオード表示装置は、既存の有機発光ダイオード表示装置の製造工程の中のモジュール工程との互換を容易に行うことができる。

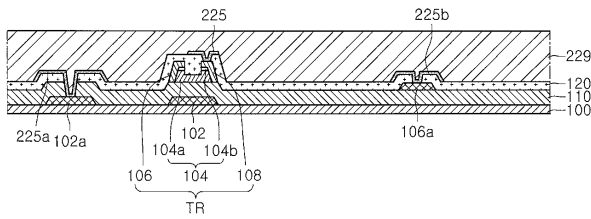
【符号の説明】

【0053】

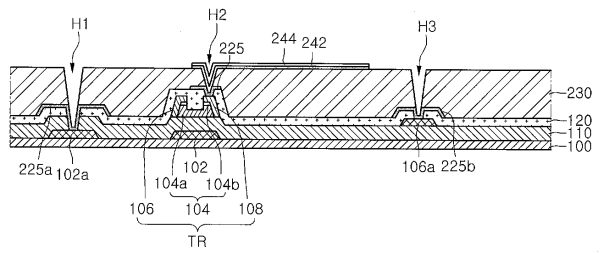
100 基板、102 ゲート電極、102a ゲートパッド下部電極、103 非晶質シリコン薄膜、104 半導体パターン、104a 活性層、104b オーミックコンタクト層、106 ソース電極、108 ドレイン電極、110 ゲート絶縁膜、120 保護層、122 第1導電パターン、122a 第1ゲートパッド上部電極、123
20
第1導電層、124 第2導電パターン、125 第2導電層、124a 第2ゲートパッド上部電極、124b 第2データパッド上部電極、130、230 平坦化層、139 第3金属層、140 カソード電極、200 金属基板、225a ゲートパッド上部電極、225b データパッド上部電極、229 平坦化パターン、241、243 第3及び第4金属層、242、244 第1及び第2カソード電極、249 バンク層、250 バンクパターン。

A cross-sectional view of a semiconductor device. The device consists of a substrate with multiple layers. A central structure is formed on the substrate, featuring a central core (102) and a surrounding layer (104). The core (102) is divided into two parts: 102a and 102b. The surrounding layer (104) is divided into two parts: 104a and 104b. The central structure is flanked by two side regions (106 and 106a). The substrate is labeled with 100 and 101. A vertical dimension line on the right indicates a height of 19.

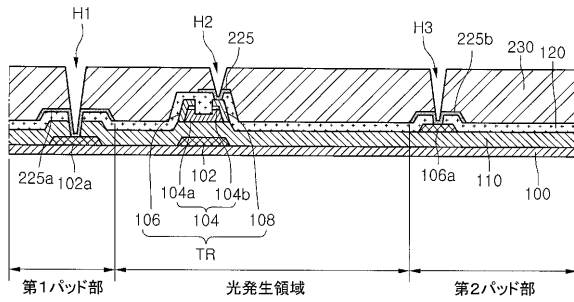
【図 4 K】



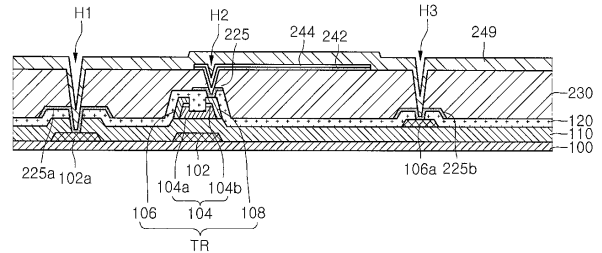
【図 4 N】



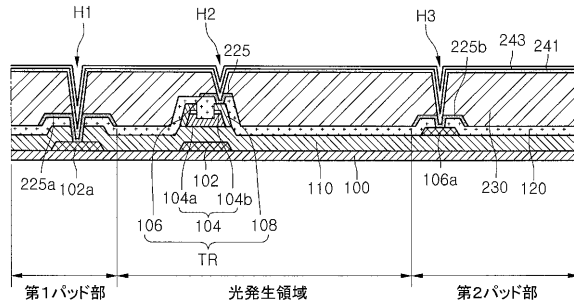
【図 4 L】



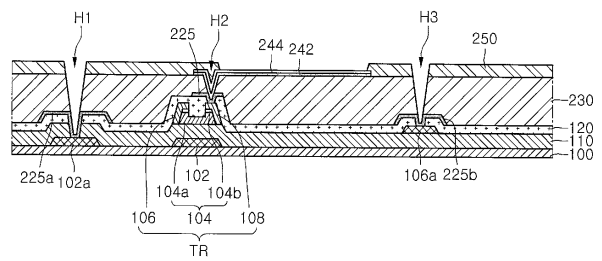
【図 4 O】



【図 4 M】



【図 4 P】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	
H 0 5 B	33/10	(2006.01)	H 0 5 B 33/10
H 0 1 L	27/32	(2006.01)	G 0 9 F 9/30 3 6 5 Z
H 0 5 B	33/22	(2006.01)	H 0 5 B 33/22 Z

(72)発明者 ヨンチョル・キム
大韓民国、キョンギ - ド、パジュ - シ、ウォルロン - ミョン、トグン - リ、パジュ・エルシーディ
ー・インダストリアル・コンプレックス、チョンダウン・マウル 1 0 3 - 1 4 1 1

(72)発明者 ジュンソク・ユ
大韓民国、キョンギ - ド、コヤン - シ、イルサンソ - グ、テホウ - ドン、テホウ・マウル・9ダン
チ・アパートメント 9 0 3 - 1 1 0 1

審査官 東松 修太郎

(56)参考文献 特開 2 0 0 8 - 2 3 5 2 4 8 (J P , A)
特開 2 0 0 9 - 0 2 7 0 3 7 (J P , A)
特開 2 0 0 5 - 1 9 6 1 7 2 (J P , A)

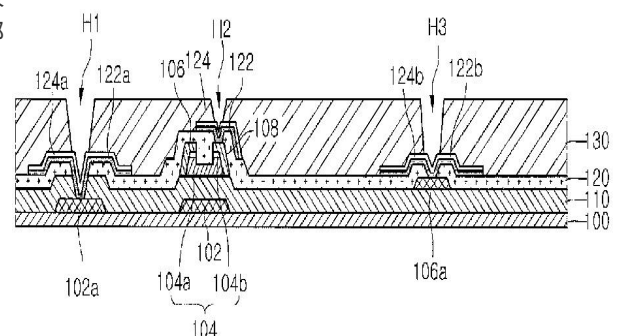
(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)
H 0 1 L 5 1 / 5 0 - 5 1 / 5 6
H 0 1 L 2 7 / 3 2
H 0 5 B 3 3 / 0 0 - 3 3 / 2 8
G 0 9 F 9 / 3 0

专利名称(译)	逆结构顶部发光型有机发光二极管显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP4902726B2	公开(公告)日	2012-03-21
申请号	JP2009284940	申请日	2009-12-16
[标]申请(专利权)人(译)	乐金显示有限公司		
申请(专利权)人(译)	Eruji显示有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	Eruji显示有限公司		
[标]发明人	ヨンチョルキム ジュンソクユ		
发明人	ヨンチョル·キム ジュンソク·ユ		
IPC分类号	H01L51/50 G09F9/30 H05B33/02 H05B33/26 H05B33/28 H05B33/10 H01L27/32 H05B33/22		
CPC分类号	H01L27/3246 H01L27/3248 H01L27/3258 H01L27/3276 H01L51/5221 H01L51/5231 H01L2227/323 H01L2251/5315 H01L2251/5353		
FI分类号	H05B33/14.A G09F9/30.338 H05B33/02 H05B33/26.Z H05B33/28 H05B33/10 G09F9/30.365.Z H05B33/22.Z G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC21 3K107/CC45 3K107/DD03 3K107/DD22 3K107/DD28 3K107/DD29 3K107/DD44X 3K107/DD44Y 3K107/DD90 3K107/EE03 3K107/EE04 3K107/GG00 3K107/HH05 5C094/AA31 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/AA44 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/DA13 5C094/DB10 5C094/EA05 5C094/EA07 5C094/EA10 5C094/FB20 5C094/GB10		
代理人(译)	英年古河 Kajinami秩序 上田俊一		
优先权	1020090015460 2009-02-24 KR		
其他公开文献	JP2010199554A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供具有高可靠性的倒置顶部发光OLED（有机发光二极管）显示器。溶剂：倒置顶部发光OLED显示器包括：第一和第二焊盘部分，其布置在布置在金属上的光产生区域上基板并产生光，并布置在光产生区域附近；形成在光产生区域上的薄膜晶体管；保护层，设置在覆盖薄膜晶体管的金属基板上，并包括接触孔，每个接触孔暴露薄膜晶体管的一部分，第一焊盘部分的一部分和第二焊盘部分的一部分；第一导电图案和第二导电图案形成在保护层上，并且与通过接触孔暴露的薄膜晶体管的一部分接触；阴极电极，形成在光产生区域上，并电连接到第二导电图案；有机发光层设置在阴极上；阳极电极，设置在有机发光层上，并由透明导电金属形成；在每个接触孔上用与第二导电图案相同的材料形成的电极图案暴露第一和第二焊盘部分。

【图 2 L】



【图 2 M】